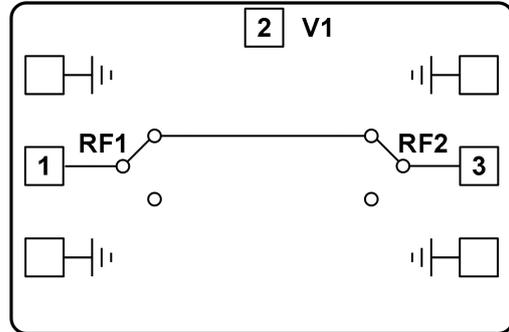




主要特点

- 隔离度: 32 dB @ 40 GHz
- 插入损耗: 0.8 dB @ 40 GHz
- 反射式设计
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1 × 0.68 × 0.1 mm³

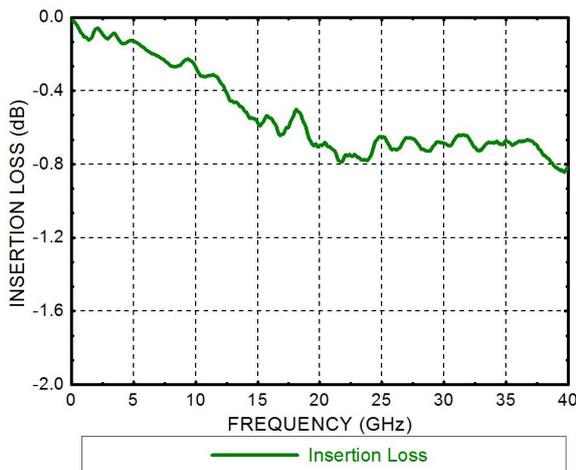
功能框图



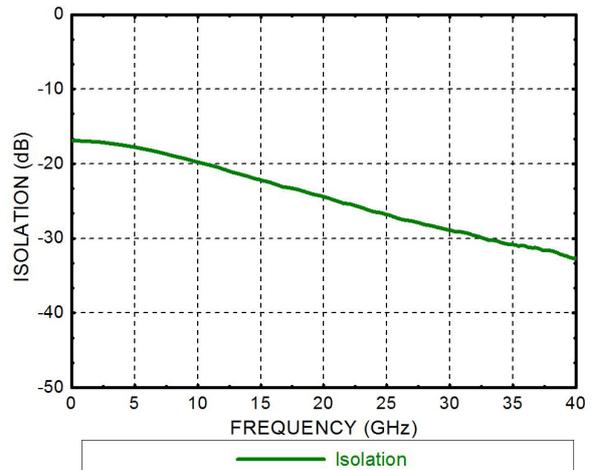
性能指标 ($T_A = +25^\circ C, V_{CTL} = 0I-5 V$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 40			GHz
插入损耗		0.8		dB
隔离度		25		dB
回波损耗“打开状态”		20		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-40GHz		25		dBm
开关切换时间		15		ns

插入损耗

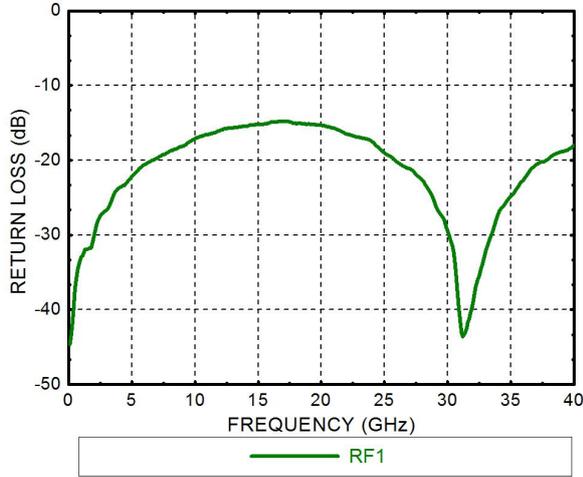


隔离度

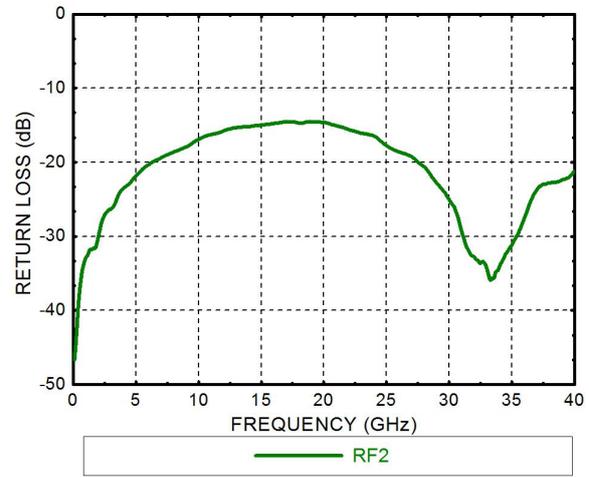




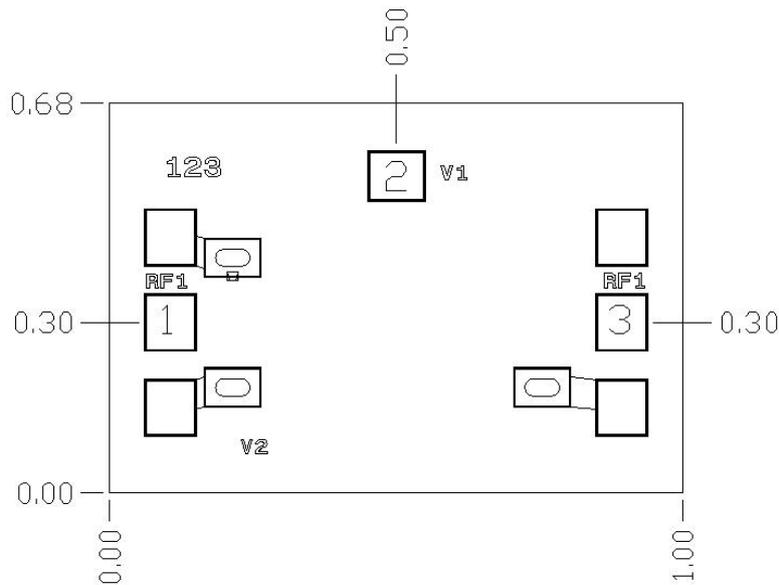
RF1端口回波损耗, “ON” 状态



RF2端口回波损耗, “ON” 状态



物理参数



焊盘描述

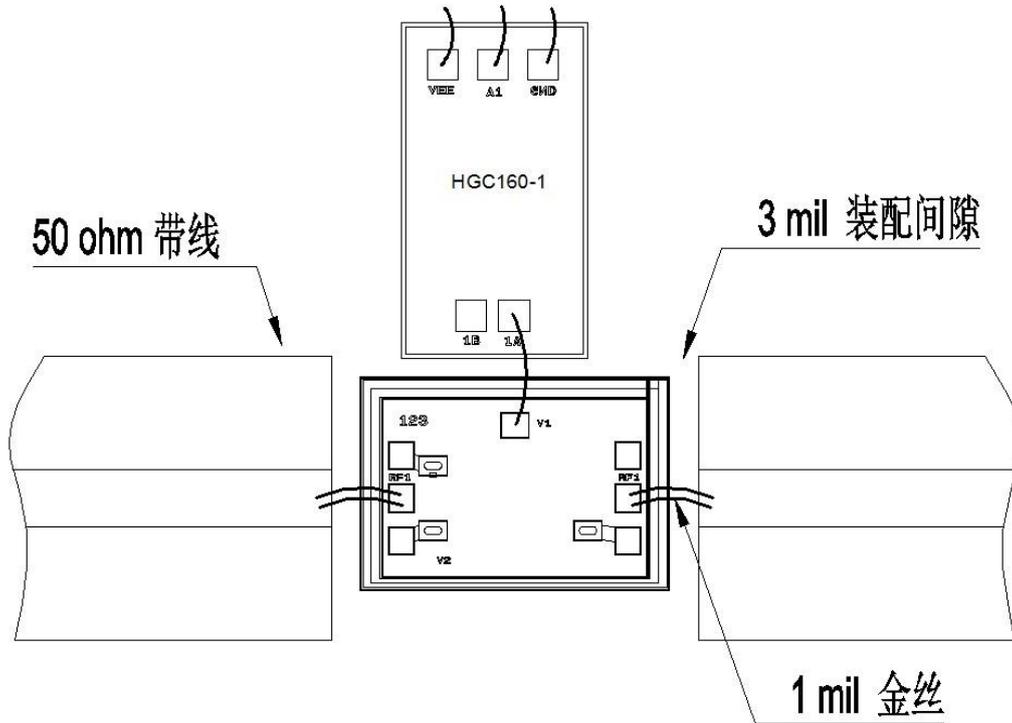
焊盘序号	功能	描述
1, 3	RF1, RF2	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2	V1	V1=-5V, 则 RF1、RF2 为 “ON” 状态; V1=0V, 则为 “OFF” 状态
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

功能	V1
ON	1
OFF	0
“0”电平范围: 0~-0.2V, “1”电平范围: -3~-6V。	

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100um²
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率: +27 dBm
2. 储存温度: -65~+150°C
3. 工作温度: -55~+85°C